

ہم نے کنڈکشن میٹلز اور انسولیٹرز سیمی کنڈکٹرز کی بنیادی باتوں کے بارے میں بات کی ہے اس لیے میں نے پچھلے لیکچر میں کیا کیا تھا اس کو دوبارہ بیان کرنے دو، اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ الگ تھلگ ایٹم کے لیے کوانٹم سٹیٹس کی ممکنہ توانائیاں مجرد ہوتی ہیں لہذا یہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایٹم ہے ممکنہ ہے اور اسی طرح یہ مختلف s دو p دو s دو توانائیاں جو الیکٹران کے پاس ہوسکتی ہیں وہ اس طرح مجرد ہیں لہذا آپ کے پاس یہ ایک توانائی کی سطحیں ہیں اور ان میں آپ کے پاس کوانٹم اسٹیٹس ہیں اور ہر کوانٹم اسٹیٹ میں صرف ایک الیکٹران سیکنڈ ہوسکتا ہے۔ حصہ اس مادے کی گیس یا بخارات کے لیے ہوتا ہے جو ایک ایٹم کے لیے دستیاب ہوتی ہے آپ کے پاس مخصوص توانائی کی سطح ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس اس مخصوص مادے کی گیس ہے جہاں بہت سارے ایٹم موجود ہیں توانائی کی سطح وہی رہتی ہے جو صرف الیکٹران پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ وہ توانائی کی سطحیں اور اس طرح یہ خاکہ یہ ویسا ہی رہتا ہے اب الیکٹران یہاں سے سب سے کم توانائی والی حال

اسے پُر کریں اور اسی طرح ایک کوانٹم اسٹیٹ پولی خارج کرنے 1 نوں سے مدار کو بھرتے ہیں اس طرح پہلے الیکٹران اسے بھریں گے پھر یہ والے اصول پر آخری غیر خالی سطح مکمل طور پر یا جزوی طور پر بھری جاسکتی ہے پھر ہم نے ٹھوس بنانے کے بارے میں بات کی جب ایٹم قریب آتے ہیں اور ٹھوس بناتے ہیں تو یہ تمام

توانائی کی سطحیں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ ایٹموں کو ٹھوس کرسٹل کی حالت بنانے کے لیے قریب لایا جاتا ہے یہ بیرونی الیکٹران بھی بانڈنگ کے ذریعے تعامل شروع کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ الیکٹران ایٹموں کو پڑوسی ایٹموں سے جوڑ دیتے ہیں لہذا یہ تعامل توانائی کی سطح کو بدل دے گا اور اس لیے توانائیاں تقریباً مسلسل

توانائی کے بینڈز میں تقسیم ہوتی ہیں تو کیا تھا؟ مجرد

توانائی کی سطحیں اب آہ انرجی بینڈز بن جاتی ہیں اس لیے توانائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں اور یہ تیز

توانائی کی سطح نہیں ہے آپ کے پاس کچھ کوانٹم سٹیٹس اوپر جاتی ہیں کچھ کوانٹم سٹیٹس نیچے جاتی ہیں اور اس طرح یہ ایک بینڈ بن جاتا ہے پھر وہ اندرونی الیکٹرانوں اور اندرونی الیکٹرانوں سے آباد ہوتے ہیں وہ اس بانڈنگ اور تعامل کی وجہ سے زیادہ  $s_2$   $s_1$  نچلی انرجی لیول جیسے 1 متاثر نہیں ہوتے ہیں اس لیے وہ بانڈنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ انرجی لیولز اب بھی کافی تیز ہیں لیکن پھر جس بیرونی کو وہ زیادہ پھیلاتے ہیں وہ بیرونی کو زیادہ پھیلاتے ہیں اور بینڈ چوڑے ہوتے ہیں پھر سب سے زیادہ مکمل طور پر بھرے ہوئے انرجی بینڈ کو سب سے زیادہ مکمل طور پر بھرا ہوا انرجی بینڈ ویلنس بینڈ کہا جاتا ہے یہ اب ام ہے۔ اور اگلا اونچی بینڈ جو مکمل طور پر نہیں بھرا ہے وہ مکمل طور پر خالی ہو سکتا ہے یا جزوی طور پر بھرا جا سکتا ہے اس لیے اگلے اونچے بینڈ کو کنڈکشن بینڈ کہا جاتا ہے تو ان چیزوں پر ہم نے اب بات کی ہے کہ اچھے کنڈکٹرز میں اچھے کنڈکٹرز میں کیا ہوتا ہے کنڈکشن بینڈ جزوی طور پر بھر جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں کنڈکشن بینڈ برابر ہے سرخ رنگ بھرا ہوا اشارہ کر رہا ہے اور نیلا خالی اشارہ کر رہا ہے تو والینس بینڈ مکمل طور پر بھرا ہوا ہے اور کنڈکشن بینڈ جزوی طور پر بھرا ہوا ہے اور یہ خالی ہے لہذا کنڈکٹرز میں اچھے کنڈکٹرز میں ترسیل بینڈ جزوی طور پر بھرا ہوا ہے بہت کم درجہ حرارت پر بھی کنڈکشن بینڈ میں کافی الیکٹران اور کنڈکشن بینڈ میں کافی خالی حالتیں ہیں لہذا یہ ایک اچھا کنڈکٹر ہے اگر آپ برقی فیڈ لگاتے ہیں تو یہ الیکٹران جو کنڈکشن بینڈ میں ہیں وہ ان چھوٹی

توانائیوں کو لے سکتے ہیں اور کوانٹم سٹیٹس میں جا سکتے ہیں جو انسولیٹروں میں بالکل دستیاب ہیں انسولیٹروں میں کیا ہوتا ہے کنڈکشن بینڈ مکمل طور پر خالی ہوتا ہے یہ کنڈکشن بینڈ مکمل طور پر خالی ہے اور والینس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کے درمیان اس طرح اب عام درجہ حرارت  $ev_4$   $ev_6$   $cv$  توانائی کا فرق بڑا ہے یہ انرجی گپ ہم اسے لکھتے ہیں مثلاً بڑا بڑا ہے یعنی کیا کہتے ہیں 3 پر جیسے کمرے کا درجہ حرارت یا اس طرح نہیں الیکٹران کوانٹم سٹیٹس کو کنڈکشن بینڈ میں آباد کرتے ہیں

تو یہ ڈھانچہ ہے اور یہ کم درجہ حرارت پر یہ والینس بینڈ مکمل طور پر بھر جاتا ہے کنڈکشن بینڈ مکمل طور پر خالی ہوتا ہے کیونکہ درجہ کے آرڈر کی تھرمل انرجی اب دستیاب ہے لیکن پھر یہ خلا ہے اتنا بڑا ہے کہ یہ والینس الیکٹران اس سے تجاوز  $kt$  حرارت میں اضافہ ہوتا ہے نہیں کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے عام درجہ حرارت پر بھی کمرے کے درجہ حرارت یا اس سے تھوڑا اوپر بھی یہ مکمل طور پر خالی ہے۔ اور کوئی ترسیل نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ انسولیٹرز میں ویلنس بینڈ مکمل طور پر بھرا ہوا ہے کنڈکشن بینڈ مکمل سے کم ہے یا عام طور پر انگوٹھے کا اصول سلیکون کے  $ev$  طور پر خالی ہے بالکل انسولیٹروں کی طرح صرف فرق اتنا ہے کہ یہ گپ 3 کے مقابلے میں یہ اب بھی بہت زیادہ ہے جو کہ کمرے کے درجہ  $k$  لیے یہ ایک پوائنٹ ایک دو ای وی ہے اس لیے اگرچہ کیپٹلٹی میں اس حرارت پر کچھ پوائنٹ صفر دو چھ الیکٹران وولٹ ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے کچھ الیکٹرانز کمرے کے درجہ حرارت پر کہا جاتا ہے کہ والینس بینڈ میں ان میں سے کچھ الیکٹران تھرمل تعاملات سے کافی

توانائی حاصل کرتے ہیں اور وہ خلا کو عبور کرتے ہیں اور کنڈکشن بینڈ میں کوانٹم سٹیٹس پر قبضہ کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ الیکٹران ویلنس بینڈ میں چھلانگ لگاتے ہیں اور وہ کوانٹم سٹیٹس پر قبضہ کرتے ہیں۔ کنڈکشن بینڈ اور اگر یہ والینس بینڈ میں ہوتا ہے

تو ایک کوانٹم سٹیٹ دستیاب ہو جاتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے تاکہ والینس بینڈ کے دوسرے الیکٹران وہاں جا کر اسے بھر سکیں۔ خلا پیدا کریں اور کسی اور جگہ ایک نئی خالی حالت بنائیں تاکہ ہمارے پاس یہ نام نہاد سوراخ یا خالی حالتیں ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم نے پچھلے لیکچر میں تبادلہ خیال کیا تھا لہذا یہ ساری بحث مستطیلوں کے لحاظ سے تھی جسے میں نے کہینچا اور اس کو

توانائی کہا۔ لیولز اور کنڈکشن بینڈ اور والینس بینڈ الیکٹران والینس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ تک جا رہا ہے لیکن اصل جسمانی تصویر کیا ہے الیکٹران میرے ڈایاگرام میں کہاں نہیں ہے جہاں الیکٹران ہے

تو آئیے ہم اس انرجی لیول ڈایاگرام کو اصل سے جوڑتے ہیں۔ سلیکان کرسٹل یا سیمی کنڈکٹر کرسٹل اور دیکھیں کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہیں لہذا اگر میں سلیکون کے حوالے سے بات کرتا ہوں ہائبرڈائزڈ کوویلنٹ بانڈنگ کے ذریعے چار ہمسایہ سلیکون ایٹموں سے  $sp^3$  تو کیا اس میں ڈائمنڈ کرسٹل کا ڈھانچہ ہے اس لیے ہر سلیکان کو اس جوڑا جاتا ہے لہذا ہم اسے یہاں دو جہتی آہ ڈایاگرام میں دکھایا جائے گا حالانکہ یہ ایک تین جہتی چیز ہے یہ ایک ٹیٹراہیڈرل قسم کی ساخت ہے لیکن سے جڑا ہوا ہے۔ ایفرینٹ سلیکون ایٹم  $d$  ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر سلیکون ایٹم چار

تو یہ تمام بانڈز ہیں اس میں دو الیکٹران ہوتے ہیں ایک الیکٹران اس سلکان کے ذریعہ شیئر کیا جاتا ہے اور یہ دونوں ان دونوں کے درمیان ایک بانڈ بناتے ہیں اسی طرح بانڈ یہاں یہاں موجود ہیں الیکٹران وہ ان بانڈز کو بنانے میں استعمال ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے  $sp^3$  تو چار بیرونی الیکٹران وہ ساتھ یہ پورا کرسٹل موجود ہے اب کنڈکشن الیکٹران کیا ہے اور کیا ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ ایک الیکٹران والینس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں چلا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس خاکہ میں یہ تمام الیکٹران جو یہاں اس بانڈ میں دکھائے گئے ہیں لوگ اسے بھی دو لائنوں کی طرح اس طرح دکھاتے ہیں کیونکہ بانڈ میں دو الیکٹران شامل ہوتے ہیں تو یہ بھی دکھانے کا ایک طریقہ ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھی میتھین کی طرح ہے جو آپ صرف کھینچتے ہیں۔ ایک لائن اور کہیں کہ بانڈ ہے  $covalent$  یہ ایک بانڈ

تو یہ تمام الیکٹران جو یہاں دو الیکٹران ہیں دو الیکٹران یہاں دو الیکٹران یہاں اور اسی طرح یہ سب والینس بینڈ میں ہیں اگر میں اس خاکہ کو یہاں کھینچتا ہوں

تو میں اسے والینس بینڈ کہوں گا اور اسے کنڈکشن بینڈ کے طور پر یہ تمام الیکٹرانوں سے مماثل ہیں یہاں اس والینس بینڈ میں ہر جگہ ہر جگہ تمام بانڈڈ الیکٹرانوں کو والینس بینڈ میں الیکٹران کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ فرض کریں ان تھرمل

توانائیوں اور تعاملات کی وجہ سے کچھ الیکٹران کو اضافی

توانائی ملتی ہے ان دو الیکٹرانوں میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں کہ اسے اضافی

توانائی ملتی ہے اور پھر یہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے فرض کریں کہ یہ بانڈ بالکل ٹوٹ گیا

تو یہ بانڈ ٹوٹ گیا اور دو الیکٹران ایک ہیں الیکٹران اب بھی موجود ہے اور دوسرا الیکٹران ٹوٹا ہوا ہے

تو آئیے اس خاکہ کو لے لیں

تو فرض کریں کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے

تو یہاں کوئی الیکٹران نہیں ہے

تو صرف ایک الیکٹران

توانائی حاصل کرنے کے بعد وہ الیکٹران کہاں چلا گیا ہے وہ کہیں چلا گیا ہے یہ ایک سلیکان ہے ایک سلیکان آن آن اور وہ الیکٹران کہیں چلا گیا ہے جو نہیں بن رہا ہے یہاں اس ہم آہنگی بانڈ کا حصہ نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ کرسٹل میں حرکت کر سکتا ہے اس طرح حرکت کر سکتا ہے۔

کہیں اور آپ کے پاس ایک اور سلیکان ایٹم ہے دوسرے سلیکان ایٹم وہ سب بندھے ہوئے ہیں وہ سب اسی طرح بندھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں کہیں بھی جا سکتا ہے یہاں یہاں میں یہ کہوں گا کہ اس اضافی

توانائی حاصل کرنے کے بعد بانڈ ٹوٹ گیا ہے اور یہ الیکٹران ترسیل میں چلا گیا ہے۔ بینڈ یہ الیکٹران اب یہاں ہے اس ترسیل بینڈ میں اس نے ایک کوانٹم حالت پر قبضہ کر لیا ہے جو ان

توانائیوں پر دستیاب ہے جو اس سے کہیں زیادہ ہے لہذا اس تھرمل تعامل کے ذریعے اسے حاصل ہونے والی

توانائی یہاں سے یہاں تک جاتی ہے یعنی یہ یہاں سے جاتی ہے۔ یہاں یا یہاں کا مطلب ہے کہ یہ کہیں بھی جا رہا ہے اور یہ بانڈ اب ٹوٹ گیا ہے اگر بانڈ ٹوٹ جاتا ہے

تو اس انرجی پر ایک کوانٹم سٹیٹ دستیاب ہوتی ہے جس پر کوئی بھی الیکٹران قبضہ کر سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس والینس بینڈ میں ایک سوراخ بنتا ہے ایک سوراخ بنتا ہے ایک خالی جگہ بن جاتی ہے۔ کوانٹم سٹیٹ بنتی ہے اور اس خالی کوانٹم سٹیٹ پر کسی بھی الیکٹران کا قبضہ ہو

سکتا ہے یہ الیکٹران دستیاب کنڈکشن بینڈ الیکٹران سے بھی آ سکتا ہے

تو ہو سکتا ہے پورے کرسٹل میں آپ کے پاس ایک الیکٹران ہو فری الیکٹران یہاں کنڈکشن الیکٹران یہاں کنڈکشن الیکٹران ہو سکتا ہے یہاں کنڈکشن الیکٹران ہو اور اسی طرح یہ کنڈکشن الیکٹران بھی آکر اس کوانٹم سٹیٹ کو ہمارے خاکہ میں بھر سکتا ہے جو ہم کہیں گے کہ یہاں ایک

الیکٹران تھا اور یہ الیکٹران گیا اور بھر گیا اس سوراخ سے پورے الیکٹران کے جوڑے تھرمل انرجی سے بنائے جا سکتے ہیں اور پورے الیکٹران کے جوڑے اس تھرمل انرجی کی وجہ سے تباہ ہو سکتے ہیں کہیں یہ

توانائی حاصل کر رہا ہے کہیں یہ

توانائی کھو رہا ہے اور اس طرح آپ کے پاس پورے الیکٹران جوڑے کی تخلیق ہے اور آپ بھی تباہی یا دوبارہ امتزاج جاری ہے اور کسی خاص

درجہ حرارت کو دیکھتے ہوئے ایک خاص درجہ حرارت پر کچھ

توازن کا نمبر ہوگا کنڈکشن بینڈ میں کتنی کوانٹم سٹیٹس بھری ہوئی ہیں اور یہاں کتنی کوانٹم سٹیٹس خالی ہیں تاکہ الیکٹران بول جوڑے کی تعداد جو مستحکم ہو جائے کہیں کہیں اگرچہ دونوں طریقوں سے یہ عمل جاری ہے نیا مکمل الیکٹران جوڑا بن رہا ہے اور وہ دوبارہ ملا رہے ہیں لیکن اوسط

آخر کار آپ کے پاس کمرے کے درجہ حرارت کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کے لیے پورے الیکٹران کے جوڑے کی ایک خاص تعداد ہے میں آپ کو کمرے کے درجہ حرارت پر کچھ ڈیٹا دوں گا جو کہ تقریباً 300 کیلون آہ سلکان ہے جس میں 5 سے 10 کی طاقت 22 ایٹم فی سینٹی میٹر

مکعب ہے کثافت نمبر کثافت کتنے ایٹم فی سینٹی میٹر مکعب اور پھر الیکٹران بول جوڑا اس درجہ حرارت پر یہ تعداد 1.5 سے 10 کی طاقت 10 فی سینٹی میٹر مکعب ہے

تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسر فی سینٹی میٹر مکعب یہ بہت سے ایٹم ہیں کیا یہ بہت سے ایٹم ہیں وہاں اور کتنے ٹوٹے ہوئے بانڈز ہیں تقریباً 10 سے پاور 10 کے

تو یہ تناسب کی قسم ہے جس کی آپ کمرے کے درجہ حرارت پر

$t$  boltzmann میں  $tk$  میں  $k$  توقع کرتے ہیں یہ 10 کی طاقت کا عنصر ہے 12 یا اس سے زیادہ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے اب بھی بہت بڑا ہے لہذا امکان چھوٹا ہے  $ev$  ہے اور وہ بینڈ گپ ایک دو  $ev$  مستقل اوقات کمرے کے درجہ حرارت پر درجہ حرارت 0.026

لیکن یہاں تک کہ یہ چھوٹا امکان بہت بڑا ہے کیونکہ آہ اس نے ان کو بنایا ہے۔ بہت سارے چارج کیریئرز یہ تمام الیکٹران اب ترسیل کے لیے دستیاب ہیں یہ تمام سوراخ اب ترسیل کے لیے دستیاب ہیں لہذا یہ بہت سے جوڑے یہ بہت سے کنڈکشن چارج کیریئرز کنڈکشن کے لیے دستیاب ہیں

چاہے امکان بہت کم ہو اور اگر آپ کسی عام کنڈکٹر سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔ تانبے کا کہنا ہے کہ تانبے کی ایٹم کثافت 8.4 میں 10 پاور 22 ایٹم فی سینٹی میٹر مکعب ٹھیک ہے اور ہر تانبے کا ایٹم یاد رکھیں کہ ہر چوتھائی ایٹم کنڈکشن بینڈ میں الیکٹران میں حصہ ڈالے گا اس لیے یہ تعداد

اس ترتیب کی ہوگی اس لیے تانبے کی چالکتا بہت زیادہ ہے۔ سلیکان کی چالکتا کے مقابلے میں لیکن اس کے باوجود اگر آپ انسولیٹر کے ساتھ موازنہ کریں

تو یہ کافی بڑا ہے اس طرح سلکان یا کوئی سیمی کنڈکٹر ترسیل کو کیسے جنم دے گا اب یہ آہ اب یہ سیمی کنڈکٹرز خالص سیمی کنڈکٹرز کو

اندرونی سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں ان کو اندرونی سیمی کنڈکٹر کہا جاتا ہے۔ ویسے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ایک تجربہ دکھایا تھا اور میں نے مواد کو گرم کیا جاتا ہے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے چالکتا اس کے برعکس بڑھ جاتی ہے جو عام  $ing$  دکھایا تھا کہ اگر ایک سیمی کنڈکٹ

دھاتی کنڈکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اگر آپ درجہ حرارت بڑھاتے ہیں

بینڈ گپ بڑھے گا وہی رہتا ہے جو  $kt$  تو یہ

تھرمل انرجی کو بڑھاتا ہے  $kt$  توانائی کا فرق رہتا ہے لہذا اگر

تو الیکٹرانوں کے ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے یا ان بانڈز کے ٹوٹ جاتے ہیں اور الیکٹرانوں کو ترسیل کے لیے آزاد کر دیا جاتا ہے تاکہ اس امکان میں اضافہ ہو جائے کہ اس تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور چارج کیریئرز بڑھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سیمی کنڈکٹر کی چالکتا بڑھ جاتی ہے جب آپ دھا

توں میں درجہ حرارت میں اضافہ کرتے ہیں جو دھا

توں میں نہیں ہوتا ہے ویلنس بینڈ تمام بھرے ہوتے ہیں اور کنڈکشن بینڈ میں ایک مقررہ تعداد ہوگی جیسے تانبے کی ترسیل کے الیکٹران مقرر ہوں اگر آپ اضافہ کرتے ہیں۔  $temp$  گے اگر آپ اس درجہ حرارت کو بڑھاتے ہیں۔ تعداد بڑھنے والی نہیں ہے لہذا ایک اور طریقہ کار ہے جہاں درجہ حرارت کو کم کریں پھر مختلف مقامات سے بکھرنے والے انٹک مقامات سے بڑھنے کی رفتار میں اضافہ ہو گا اور چالکتا کم ہو جائے گا کہ سیمی کنڈکٹرز میں بھی مظاہر موجود ہے لیکن پھر چارج کیریئرز کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان چیزوں کو بکھرنا کم اہم ہو جاتا ہے۔ اور چالکتا بڑھتا ہے ٹھیک ہے لہذا ہمارے پاس یہ اندرونی سیمی کنڈکٹر ہے جس کا مطلب ہے کہ تمام سیمی کنڈکٹنگ خصوصیات کسی بیرونی کنٹرول کی وجہ سے الیکٹران کی تعداد جو الیکٹرانوں کی ترسیل کے الیکٹران اور سوراخوں کی  $ah$  سے نہیں ہیں یہ اس کا اپنا ایک خالص مادہ ہے اور اس صورت میں کہہ سکتے ہیں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سیمی کنڈکٹرز اتنے اہم ہیں کہ اتنے طاق  $ni$  تعداد ہے آپ اسے پچھلے لیکچر میں اندرونی کے لیے تور ہیں کیونکہ ہمارے پاس چالکتا کو ٹیون کرنے کا کنٹرول ہے کیوں کہ کسی کو کسی بھی قسم کے ٹرانسمیشن برقی کرنٹ میں کم چالکتا والا مواد کیوں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ہے کنٹرول ہم اپنی ضرورت کے مطابق چالکتا کو تبدیل کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تانبے کے تانبے کے تاروں یا تانبے کے ڈھانچے کے ساتھ ایسا کریں کہ کچھ نجاست کے ایٹموں میں سے کچھ غیر ملکی ڈال کر ہم اسے نجاست کہتے ہیں حالانکہ ہم اس نجاست کو پسند کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نجاست وہ چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ خالص اور وہ سب لیکن یہاں ہم اس ڈھانچے میں کچھ ناپاک ایٹم ڈالتے ہیں اور اسے خارجی خارجی سیمی کنڈکٹر یا ڈیوڈ سیمی کنڈکٹر کہا جاتا ہے یہ ڈوپنگ کیا ہے اور یہ ڈیوڈ بر جگہ بانڈنگ ہے اور یہ سب  $covalent$  سیمی کنڈکٹر کیا ہے آپ کے پاس وہ ڈھانچہ ہے جو کرسٹل کی ساخت تمام بانڈڈ ایٹم تمام بانڈڈ ایٹم ہے یقیناً یہ سب  $sps^2$   $p^2$   $s^2$  ہے چونکہ کے برابر ہے اور آخری ایک  $z$  سلیکون سلکان سلکان ہے اب سلکان یاد رکھیں کہ یہ ٹو پی تھری ہے  $s$  بانڈنگ میں بانبرڈانڈ ہے اب اگر آپ پیریڈک کے اگلے کالم سے کوئی عنصر لیں جدول جہاں یہ آخری ہے وہ  $covalent$

ٹو پی تھری پانچ بیرونی الیکٹران ہیں  $s$  جیسے فاسفورس یا آرسینک آپ کے پاس

کسی بھی عمل کو استعمال کرتے ہوئے میں اس فاسفورس یا سنکھیا کی کچھ مقدار کو اس سلیکان  $h$  تو اگر میرے پاس سلکان ہے اور پھر ایک

کرسٹل میں پھیلاتا ہوں اور اگر میرا عمل اچھی طرح سے وضع کیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے

تو یہ فاسفورس ایٹم سلیکون کی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں گے اور کچھ سلیکون کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس فاسفورس یا آرسینک سے

تو کیا ہوگا اگر یہ کہہ دیں کہ یہ سب سلیکون ہے اور اس خاص چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فاسفورس ہے

تو یہ سب سلیکون ہے یہ سب سلیکون ہے یہ سب سلیکون ہے لیکن یہاں میں وہ پینٹا وولینٹ مواد لا رہا ہوں جو ایک خاص ایٹم ہے۔ یہاں بیٹھ کر یہ

ایک نیوٹرل ایٹم ہے اس میں اتنے ہی پروٹون ہیں جتنے الیکٹران کی تعداد اور پھر یہ نیوٹرل ایٹم یہاں آتا ہے وہاں پانچ بیرونی الیکٹران ہیں وہ پانچ

الیکٹران اس مخصوص کرسٹل ڈھانچے میں اس مخصوص کرسٹل ڈھانچے میں کہاں جائیں گے کہ سلیکون ان میں سے چار الیکٹران اس بانڈنگ کا

حصہ ہوں گے ان میں سے چار الیکٹران اس بانڈنگ کا حصہ ہوں گے جہاں پانچواں ہے پانچواں ٹی پر نہیں ہوگا۔ اس کی

توانائی کی سطح یہ ایک اعلیٰ

توانائی کی سطح پر ہوگی لہذا یہ اس سے منسلک ہے لیکن پھر

توانائیاں بہت زیادہ ہیں

توانائیاں بہت زیادہ ہیں کسی بڑے مدار پر جا رہی ہیں یا اس سے زیادہ اور پھر بندھن بہت کمزور ہے بانڈنگ بہت کمزور ہے اس مخصوص الیکٹران

ٹھیک ہے  $mev$  کہتے ہیں کہ  $50$   $mevs$  کا اس سے کافی کمزور حساب لگایا جا سکتا ہے اور یہ بانڈنگ نکلتی ہے کہ کچھ دسیوں

تو اس طرح یہ خاص اضافی پانچواں الیکٹران اس کے لیے جو

توانائی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ویلنس بانڈ انرجی ہے لہذا اگر میں دوبارہ اپنے ویلنس انرجی ڈیاگرام پر جاؤں

تو ہمارے پاس یہ ویلنس بینڈ ہے یہاں ہمارے پاس یہ کنڈکشن بینڈ ہے یہ تمام بانڈنگ الیکٹران ان میں

توانائیاں ہیں جو اس انرجی بینڈ میں اس رینج میں اس چوڑائی میں پڑی ہیں لیکن یہ ایک اس میں بہت زیادہ

توانائی ہے کہ یہ یہاں کہیں اس کنڈکشن بینڈ کے قریب ہے

تو یہ نئی

توانائی کی سطحیں اس کنڈکشن بینڈ کے بالکل نیچے یہاں

یہ فرق چھوٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ  $50$   $mev$  توانائی کی نئی سطحیں بنتی ہیں اور یہ خلا چھوٹا ہے یہ ملی الیکٹران وولٹ میں ہے۔  $50$

دیتے ہیں اور یہ الیکٹران اس پیرنٹ ایٹم سے الگ ہو جائے گا  $mev$

تو اگر ایسا ہوتا ہے

تو یہ کنڈکشن بینڈ میں جائے گا لہذا الیکٹران پہلے سے ہی ان کو انٹم حال

توں میں یہاں موجود ہے یہ الیکٹران الیکٹران اس طرح آپ یقیناً ایک فاسفورس ایٹم آہ نہیں ڈالیں گے چاہے وہ پی پی اہم ایک حصہ فی ملیں ہو

تو فی دس میں پاور سکس ایک ہے اور پھر یاد رکھیں فی سینٹی میٹر مکعب آپ کے پاس دس کی طاقت ہائیس ہے

تو بہت سارے ہیں۔ اس طرح یہ تمام الیکٹران جو وہاں موجود ہیں وہ ان سطحوں میں ہیں یہ نجاست کی سطحیں ہیں یا ڈونر لیولز ہیں اس لیے یہ

ایک چھوٹی  $mev$  یہاں بنائے گئے ہیں لیکن پھر  $50$

توانائی ہے اس لیے تھرمل تعاملات سے اس خلا کو آسانی سے عبور کیا جا سکتا ہے اور یہ تمام الیکٹران زیادہ تر حرکت کریں گے۔ ان میں سے

کنڈکشن بینڈ میں منتقل ہوجائے گا کنڈکشن بینڈ میں منتقل ہوجاتا ہے یعنی یہ اس ایٹم سے اس ایٹم تک جانے والے اس کرسٹل میں کہیں بھی جانے کے

لئے آزاد ہوجاتا ہے جو اس ایٹم کی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح آپ کو یہ کیسے ملے گا

تو اب عام الیکٹران بول کی پیداوار اور دوبارہ ملاپ سے کیا ہوتا ہے آپ کے یہاں کچھ تعداد میں سوراخ تھے اور یہاں کچھ تعداد میں الیکٹران تھے

تھے اس کے سب سے اوپر یہ تمام الیکٹران اب دستیاب کرائے گئے ہیں اس طرح کنڈکشن بینڈ میں اب آپ کے پاس اس سے  $nh$  اور  $ne$  جو کہ

بہت زیادہ الیکٹران ہیں یہاں ہر سوراخ کے لیے آپ کے پاس ایک الیکٹران ہے لیکن یہ ناپاکی کی سطح ہمیں کنکشن بینڈ میں بہت سے زیادہ الیکٹران

دے رہی ہے لہذا ترسیل کے الیکٹران کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اس نجاست کی وجہ سے سوراخوں کی تعداد اور ایک اور مظاہر ہے کہ

الیکٹران بول کے جوڑوں کی یہ تعداد جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا اس کا انحصار اس درجہ حرارت پر ہوتا ہے جو ایک

توازن کی حالت ہے جس میں نئے سوراخ والے الیکٹران پیدا ہو رہے ہیں اور وہ الیکٹران بول کے جوڑے دوبارہ ملاپ کی وجہ سے تباہ ہو جاتے

ہیں۔ اور کچھ

توازن والی چیز ہو رہی ہے اس تخلیق کا امکان اور اس دوبارہ امتزاج کا امکان اب ایک خاص سطح پر ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں بہت سارے

الیکٹران ہیں

تو اس سوراخ میں الیکٹران کے جانے کا امکان اس سوراخ کو دوبارہ ملانے سے بہت بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اندرونی صورت میں آپ کے پاس ترسیل کے الیکٹرانوں کی تعداد بہت کم تھی لہذا ایک الیکٹران جا کر اس خالی جگہ کو پُر کرتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ امکان کم ہے۔ اصل کرسٹل میں کرسٹل کی شرائط ہاں اگر یہاں کوئی بانڈ ٹوٹا ہوا ہے اور کچھ مفت الیکٹران دستیاب ہیں تو وہ مفت الیکٹران یہاں آکر اس خلا کو پُر کرسکتے ہیں اگر آپس بہت سارے مفت الیکٹران دستیاب ہیں تو اس خلا کو پُر کرنے سے یقینی طور پر اضافہ ہوگا لہذا ان خالی آسامیوں کو پُر کرنے کی دوبارہ جمع کرنے کی شرح بڑھے گی اور اس وجہ سے سوراخوں کی تعداد مزید کم ہوجائے گی اندرونی صورت میں ہمارے پاس سوراخوں کی تعداد میں کچھ سوراخ تھے لیکن جب ہم نجاست پیٹاؤلنٹ نجاست ڈال رہے ہیں اتے of recombination تو ہم ٹھیک الیکٹران کی تعداد میں اضافہ ایک ہی وقت میں سوراخوں کی تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ اس دوبارہ ملاپ میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح اگر میں کہوں کہ اگر میں اس اندرونی سے موازنہ کرتا ہوں

تو ہم کہیں کہ ہم یہاں کچھ علامت رکھ دیں تو اس صورت میں اگر میں اس کے ساتھ موازنہ کروں سے  $nh$   $ni$  ہے لیکن  $nh$  ہے اور یہ  $ni$  بھی صحیح ہے اس ڈیش کی ضرورت  $nh$  سے بڑا ہے جو سمجھ میں آتا ہے اور یہ  $ni$  تو یہ چھوٹا ہے یہ ہم بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکٹرانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ دوبارہ ملاپ بڑھنے کی وجہ مربع  $n$  میں بدلتا ہے جو  $ne$   $nh$  سے سوراخوں کی تعداد کم ہونی ہے اور پھر کوئی ریاضی کر سکتا ہے۔ کچھ نظریہ اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے لیکن پروڈکٹ وہی رہتی ہے لہذا اگر یہ ہے کہ اگر ڈوپنگ نہیں  $n$   $h$  بڑھ رہا ہے  $ne$  مربع بہت دلچسپ  $ni$  نکلنا ہے بہت دلچسپ ہے

تو پھر بھی پروڈکٹ وہی رہتی ہے لہذا یہ بہت دلچسپ ہے ٹھیک ہے کوئی اس پر کچھ عددی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو عددی مسئلہ فرض کریں کہ آپ کے پاس خالص سیلیکون ہے بغیر ڈوپنگ اور کمرے کے درجہ حرارت پر فی ایٹموں کی کل تعداد یونٹ والیوم فی یونٹ والیوم ہے 5 سے 10 پاور 28 فی میٹر مکعب فی میٹر مکعب پہلے میں نے فی سینٹی میٹر مکعب کے لحاظ سے بات کی تھی اور اسی وجہ سے یہ 10 پاور 28 پر چلا گیا ہے نہ کہ 10 پاور 22 اور پھر اس درجہ حرارت پر ہم کہتے ہیں کہ سوراخ کی کثافت اور الیکٹران کی کثافت دونوں برابر اندرونی کثافت ہیں اور یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1.5 سے 10 پاور 16 فی میٹر مکعب اب ہم ایک پیٹاؤلنٹ ناپاک آرسینک ڈالتے ہیں ہمیں آرسینک 1 پی پی ایم کہتے ہیں پی پی پی پی ایم کا مطلب ہے حصے فی ملین یعنی 10 میں 1 سے پاور 6 تو فی یونٹ حجم کے ایٹموں کی تعداد جو بھی ہے 10 سے پاور 6 میں ایک حصہ اس آرسینک سے بدل گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈوپنگ کے کتنی ہے لہذا یہی مسئلہ ہے میں نے اس  $nh$  بعد یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ الیکٹران کثافت کنڈکشن الیکٹران کی کثافت کتنی ہے؟ اور پوری کثافت ڈیٹا کو بولڈ پر کاپی کیا ہے اور ہم اسے وہاں حل کرتے ہیں

تو میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں گا کہ ہم نے ان ناپاک سطحوں کے ذریعے بنائے گئے اضافی الیکٹران کنڈکشن الیکٹران کی تعداد ایک ہو فی ناپاک ایٹم ٹھیک ہے ایک ایٹم پیٹاؤلنٹ پانچ الیکٹران چار بانڈنگ میں جاتے ہیں ایک اضافی ہے یعنی ناپاک کی سطح پر جاتا ہے اور وہاں سے کنڈکشن لیول پر جاتا ہے تاکہ ان الیکٹرانوں کی تعداد آہ ہو جو اس کی وجہ سے بنتی ہے۔ ڈوپنگ جو کہ ایک پی پی پی ایم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ سے دس سے طاقت کے اٹھائیس ایٹم ہیں اے ایچ ایک ہائے 10 سے پاور 6 جو کہ 5 سے 10 سے پاور 22 ہے یہ بہت سے نئے کنڈکشن الیکٹران لگانے جا رہے ہیں

تو کنڈکشن ہو رہے ہیں۔ اندرونی عمل سے الیکٹران لیکن یہ تعداد چھوٹی ہے کہ تعداد 10 سے پاور 16 بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹا ہے لہذا اصل تعداد یہ ہے اور یہ ہے لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے برابر ہے یہ اور پھر الیکٹرانوں کی تعداد میں کوئی بھی سوراخوں کی تعداد میں وہی رہنا چاہئے جو ڈوپنگ سے آزاد ہے لہذا یہ آپ کا نی مربع اور نی مربع ہے آپ اسے یہاں سے لے اسکوائر بھی ہوگا اور وہ سب لیکن بہرحال میں اب ان اکائیوں میں اس کی بات کر  $wi$  سکتے ہیں یہ 2.25 ہے اور یقیناً 32 کی طاقت ہے یونٹ رہا ہوں

پانچ میں تقسیم کیا جائے گا۔ دس  $ne$  اور  $ne$  نمبر کیا ہوگا اس دو پانچ سے دس کے بتیس کی طاقت کے برابر ہوگا اور  $hnh$  تو سوراخوں کا ایک پاور بائیس

تو کام کریں کہ یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے یہ 0.45 سے 10 کی طاقت 10 یا 4.5 میں 10 سے پاور 9 فی میٹر مکعب ٹھیک ہے تو سوراخوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اصل میں یہ سوراخوں کی تعداد تھی وہاں سے اب یہ کم ہو گیا ہے اس قسم کے خارجی سیمی کنڈکٹرز میں قسم کے سیمی کنڈکٹرز کہا جاتا ہے اس لیے جب  $n$  الیکٹران کنڈکشن الیکٹران کی تعداد سوراخوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے انہیں قسم کے سیمی کنڈکٹرز آپ کے پاس  $n$  سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں  $nh$  اس وقت  $ne$  آپ ان چیزوں کو ڈوپ کرتے ہیں اور دوسری قسم ہے جہاں آپ ان پیٹاؤلنٹ چیزوں میں نہیں جاتے ہیں جو آپ بوران یا ایلمینیم یا گیلیم جیسی چھوٹی چیزوں کے لئے جاتے ہیں ان کے ٹو پی لہذا اگر میں سیمی کنڈکٹرز بناؤں ایک سیلیکون لیں اور پھر وہ تمام تھرمل پروسیسنگ ڈفیوزر یا جو  $s$  بیرونی خول میں تین الیکٹران ہوتے ہیں کچھ بھی تجویز کیا گیا ہے کریں اور ان میں سے کچھ معمولی نجاست

توں کو پھیلا دیں کہ کیا ہوگا اگر میں اس ڈھانچے کے لئے جاؤں تو میرے پاس یہاں سیلیکان ہے میرے پاس یہاں ہر جگہ سیلیکان ہے میرے پاس سلکان ہے اور وہ سبھی پڑوسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہاں کہیں ہمارے ایک قبائلی ہیں کہ ہم بورون کہتے ہیں

تو یہ سب سیلیکون ہے یہ ضروری ہے کہ ڈوپنگ کے اس عمل کے دوران ہم کرسٹل کے ڈھانچے کو تباہ نہ کریں کہ کرسٹل کا ڈھانچہ وہی رہے بانڈنگ اور ان چیزوں پر  $covalent$  تاکہ آپ کے پاس اب بھی تمام چیزیں موجود ہوں۔

لیکن یہاں بوران صرف تین الیکٹران کے ساتھ آتا ہے  $covalent$  bond تو آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں یہاں تمام بانڈنگز ہیں دو الیکٹران فی میں حصہ نہیں لے سکتا اور اس لیے یہ خاص طور  $covalent$  bond بانڈز میں حصہ لے سکتا ہے چوتھے  $covalent$  اس لیے یہ تین پر ایک بڈی میں سے ایک سٹیٹس خالی ہو گی

تو آپ کے پاس دو الیکٹران ہیں یہاں دو کوائٹم سٹیٹس ہیں لیکن کیونکہ اس میں چار الیکٹران نہیں ہیں اس میں صرف تین الیکٹران ہیں یہ تین الیکٹران کے ساتھ آیا ہے اور اس وجہ سے آپ کے پاس ایک سوراخ ہے یہاں آپ کے پاس خالی حالت ہے یہاں یہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے

تو ایک سوراخ ہوتا ہے لیکن اس سوراخ کی توانائی مختلف ہوتی ہے اگر کوئی سوراخ ہو

تو اس سوراخ کی

توانائی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پیدا ہوتا ہے اگر یہاں ایک سوراخ ہوتا ہے

تو یہاں سلکان سلکان بانڈ ہوتا ہے اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو سوراخ یہاں پیدا ہوتا ہے وہ مختلف

توانائیاں ہے اگر ایک الیکٹران آتا ہے اور یہاں بیٹھتا ہے



تو الیکٹرانز کے لیے اس

توانائی کو اٹھانا اور کہیں اور جانا ممکن ہو

تو وہ جواب دیں گے ورنہ اگر الیکٹران موجود ہیں

تو وہ ایسا نہیں کریں گے اور یہ برقی میدان ہے۔ وہاں یہ کہ الیکٹران کی حرکت برقی میدان کی سمت کے مخالف برقی فیلڈ کے مطابق ہوگی

کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ سوراخوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے  $t$  velocity تو اس سے ترتیب حرکت کے اوپری حصے پر آہ منظم ڈراف

والینس الیکٹران بھی اس برقی میدان کی چونکی کو محسوس کریں گے لیکن پڑوس میں اگر کوئی خالی حالتیں نہیں ہیں

تو وہ صرف وہیں رہیں گے وہ برقی میدان کا جواب نہیں دیں گے لیکن اگر آس پاس میں ہوں کچھ ٹوٹا ہوا بانڈ ہے اور الیکٹران کو سوراخ کی اس

سمت میں صحیح سمت میں دھکیلنے کے لیے الیکٹرون فیلڈ موجود ہے یاد رکھیں کہ قوت منفی چارج کی وجہ سے مخالف ہے لہذا اگر الیکٹران کو

ایک خاص سمت میں دھکیلنے کے لیے برقی فیلڈ موجود ہے۔ وہ سمت صرف پڑوس میں کچھ ٹوٹا ہوا بانڈ ہے وہاں اس والینس الیکٹران کو وہاں جانے

اور بھرنے کا اشارہ کیا جائے گا تاکہ برقی میدان کی وجہ سے سوراخ بھی ترجیحی سم

توں میں داخل ہوں گے اور الیکٹران بھی کنڈکشن الیکٹران بھی اندر جائیں گے۔ اس فیلڈ کی وجہ سے مناسب ترجیحی سمتیں ہیں اور اس وجہ سے

آپ کے پاس ترسیل ہے آپ کے پاس الیکٹران کی وجہ سے کرنٹ ہے اور سوراخوں کی وجہ سے بھی اس مواد میں کل کرنٹ ان ترسیلی الیکٹرانوں

کی وجہ سے ہوگا اور یقیناً ان سوراخوں کی وجہ سے دونوں برابر نہیں ہیں آپ یہ نہیں سوچتے کہ نمبر ایک الیکٹران کی تعداد سوراخوں کی تعداد

یا سوراخوں کی تعداد کے مقابلے بہت زیادہ ہوسکتی ہے۔ ترسیل کے الیکٹرانوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت بڑے ہوں اور اس لیے یہ دونوں

برابر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ نقل و حرکت اگر کسی برقی فیلڈ کو لاگو کیا جائے

تو یہ کتنا کرنٹ پیدا کرے گا تاکہ یہ الیکٹرانوں اور سوراخوں کے لیے بھی مختلف ہو اور اس لیے دونوں کسی بھی صورت میں برابر ہونے کی

ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ اندرونی سیمی کنڈکٹرز کے لیے بھی اس کے باوجود آپ کے پاس سوراخوں کی وجہ سے ترسیل ہے جس کا مطلب ہے

کہ آپ کو بندھے ہوئے الیکٹرانوں کی وجہ سے ترسیل ہے یہ دھا

توں میں ایک نئی خصوصیت ہے جو ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس مفت الیکٹران ہوں

تو آپ کے پاس جو دھاتی ہیں ان میں کنڈکشن الیکٹران ٹھیک ہیں اور اس وجہ سے سیمی کنڈکٹرز میں کنڈکشن آپ کے پاس ان کنڈکشن الیکٹرانوں کی

وجہ سے ہے اور یہ بھی والینس الیکٹران کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں وہ صرف ایٹموں کو اس بانڈ سے پڑوسی ٹوٹے ہوئے بانڈ میں تبدیل کر رہے

ہیں اور اسی طرح یہ دونوں سیمی کنڈکٹرز میں ترسیل میں حصہ ڈالتے ہیں لہذا میں خلاصہ کرتا ہوں کہ ہم نے اس لیکچر میں کیا کیا بنیادی طور پر

ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خاکے جو میں کنڈکشن بینڈ اور والینس بینڈ بناتا ہوں یہ خاکے ہم بناتے ہیں اور اصل کرسٹل کے لحاظ

سے ان خاکوں کا کیا مطلب ہے جو کہ پہلا حصہ تھا اور ہم نے کہا کہ سیمی کنڈکٹرز میں یہاں ایٹم اور یہ ایٹم ایٹموں کے بیرونی الیکٹران سے

بانڈنگ میں حصہ لیں اور پھر یہ تمام الیکٹران جو ان بانڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں ان الیکٹرانوں میں  $covalent$  جڑے ہوئے ہیں اس

توانائیاں ہوں گی جو اس والینس بینڈ میں ہوں گی یہ کوانٹم سٹیٹس یہاں بانڈنگ الیکٹران سے مطابقت رکھتی ہیں جب کہ اگر کچھ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اور

الیکٹران کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کرسٹل جو کسی ایٹم سے کمزور طور پر جڑا ہوا ہے کہ الیکٹران میں

توانائی ہوگی جو کنڈکشن بینڈ میں ہوگی پھر ہم نے بات کی کہ الیکٹران کیسے چھلانگ لگاتے ہیں والینس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ تک

تو اگر آپ کے پاس ایک الیکٹران ہے جو یہاں اس والینس بینڈ میں بیٹھا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کنڈکشن بینڈ کی طرف جاتا ہے اس سے ہمارا

کیا مطلب ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بانڈ ٹوٹا ہے کچھ بانڈ اس بانڈ میں دو الیکٹران یہاں ہیں اس لیے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک الیکٹران اس بندھن سے آزاد

ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہیں اور جا سکتا ہے کمزوری سے جکڑا ہوا ایٹم ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بدل سکتا ہے اور اس لیے پورے کرسٹل میں

حرکت کر سکتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ الیکٹران اس بندھن سے اس آزاد حالت میں چلا گیا ہے آزاد ریاست نہیں بلکہ تقریباً آزاد حالت میں اور

یہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک سوراخ پیدا ہوتا ہے جب یہ الیکٹران یہاں سے یہاں تک جاتا ہے

تو ہم کہتے ہیں کہ ایک سوراخ اس مخصوص کوانٹم حالت میں پیدا ہوتا ہے جس میں الیکٹران ہوتا ہے۔ اب خالی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے اندرونی

سیمی کنڈکٹرز کے بارے میں بات کی جب آپ نے کوئی ایسی چیز ڈوپ نہیں کی ہے جسے اندرونی سیمی کنڈکٹر کہا جاتا ہے اور اس صورت میں

ان خالی حال  $r$  کیا ہے یہ ترسیل الیکٹران کی تعداد کی کثافت ہے اور یہ نمبر ہے  $nh$  اور  $ne$

$i$  کے برابر نہیں ہے جسے ہم  $nh$  توں یا سوراخوں کی کثافت فی سینٹی میٹر مکعب یا فی میٹر مکعب جو بھی آپ لیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس

میں لکھتے ہیں اب سب سے ام حصہ آپ ڈوپنگ کر سکتے ہیں سب سے ام حصہ کیونکہ یہ ڈوپنگ ہے جو ہمیں چالکتا پر کنٹرول دیتا ہے لہذا آپ

کچھ ایسے عناصر کو ڈوپ کر سکتے ہیں جو الیکٹران سے زیادہ سوراخ بنا سکتے ہیں یا جو سوراخوں سے زیادہ الیکٹران بنا سکتے ہیں لہذا اگر آپ

سلیکون میں آرسینک یا فاسفورس جیسی پینٹا ویلنٹ نجاست کو ڈوپ کرتے ہیں

کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے  $ne$  تو آپ کو وہ چیز ملتی ہے جسے ہم

تو ہم اس ڈوپنگ کے بارے میں سمجھنے کے لئے یہ بہت ام حصہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اسے پینٹا ویلنٹ ناپاک لگاتے ہیں

تو آپ کے پاس چارج کی کثافت درست نہیں ہے اور آپ کے پاس سوراخوں سے کہیں زیادہ الیکٹران ہیں یہ نہیں سوچتے کہ مواد اس قسم کے

کا مطلب ہے  $n$  ٹائپ این ٹائپ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے  $yn$  ٹائپ سیمی کنڈکٹر اور  $n$  منفی چارج ہو جاتا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز کو

قسم کا سیمی  $n$  ہے گیٹیو جو منفی ہے یہ الیکٹران ہیں اور اسی وجہ سے اسے  $ne$  منفی اور منفی چارج کیریئر اکثریتی چارج کیریئر جو کہ

کنڈکٹر کہا جاتا ہے لیکن چارج کثافت ابھی بھی صفر ہے آپ نے کیریئر کو چارج کیا ہے لیکن کثافت چارج نہیں ہے کیونکہ آپ صرف نیوٹرل ایٹم

کو ڈوپ کرتے ہیں آپ صرف نیوٹرل ایٹم کو ڈوپ کرتے ہیں اگر میں برقی لگاؤں

تو کیا ہوگا فیلڈ اگر میرے پاس سیمی کنڈکٹر الیکٹران ہیں

تو کیا سوراخ ہیں صحیح ایک بڑا ہو سکتا ہے ایک چھوٹا ہو سکتا ہے یا وہ برابر ہو سکتا ہے اگر میں اسے بیٹری سے جوڑتا ہوں اگر میں برقی فیلڈ

لگاتا ہوں

تو کیا ہوتا ہے یہ الیکٹرون فیلڈ معمول کے مطابق الیکٹران چلانے کی کوشش کرتا ہے ایک سمت میں اور دوسری سمت میں پکڑا ہوا ہے لہذا آپ

دونوں کی وجہ سے کرنٹ ہے لہذا کرنٹ الیکٹران کی حرکت کی وجہ سے ہے اور پوری حرکت کی وجہ سے ہے لہذا ہم نے اس لیکچر میں بھی

جنکشن لیں گے۔ اور دوسری چیزیں اگلے لیکچر میں آپ کو  $pn$  کیا اور یہاں سے ہم آلات کے بارے میں